

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成21年4月2日(2009.4.2)

【公表番号】特表2008-530312(P2008-530312A)

【公表日】平成20年8月7日(2008.8.7)

【年通号数】公開・登録公報2008-031

【出願番号】特願2007-555373(P2007-555373)

【国際特許分類】

C 08 L 101/00	(2006.01)
C 08 L 83/04	(2006.01)
C 08 L 83/02	(2006.01)
B 01 J 20/18	(2006.01)
B 01 J 3/00	(2006.01)

【F I】

C 08 L 101/00	
C 08 L 83/04	
C 08 L 83/02	
B 01 J 20/18	E
B 01 J 3/00	A

【手続補正書】

【提出日】平成21年2月10日(2009.2.10)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

POSS及びPOSSからなる群より選択されるナノ構造材料で、ゼオライト若しくは分子篩の内部表面を被覆することを含むゼオライト若しくは分子篩の透過性の調整方法であって、ゼオライト若しくは分子篩の気体分離特性が、被覆の結果変性されたものである、方法。

【請求項2】

請求項1記載の方法であって、ゼオライト若しくは分子篩は、無溶媒技術及び超臨界流体支援技術から成る群より選択される技術を使用して、ナノ構造材料で被覆される方法。

【請求項3】

請求項2記載の方法であって、その技術が、溶融状態処理法、噴霧処理法、流動処理法及び混合処理法から成る群より選択される処理方法である方法。

【請求項4】

請求項1記載の方法であって、ナノ構造材料が、 POSS-シラノール、式[(RSiO<sub>1.5</sub>)<sub>4</sub>(R<sup>1</sup>XSiO<sub>1.0</sub>)<sub>3</sub>]#のシロキサイド、ポリシリセスキオキサン[(RSiO<sub>1.5</sub>)<sub>n</sub>]#及びPOSS断片[(RSiO<sub>1.5</sub>)<sub>m</sub>(R<sup>1</sup>XSiO<sub>1.0</sub>)<sub>n</sub>]#から成る群より選択される化合物由来であり、ここで、RとR<sup>1</sup>は、有機置換基を表し、同一か異なることができ、Xは、官能基であり、m及びnは、式の化学量論を表し、#は、ナノ構造を表し、#は、ナノ構造内に含まれる珪素原子の数を表す、方法。